

Обозначение сигналов (выводов) микросхем

Наименование вывода	Обозначение
Адрес	A
Тактовый сигнал	C
Строб адреса столбца	CAS
Строб адреса строки	RAS
Выбор микросхем	CS
Разрешение	CE
Запись	WR(write)
Считывание	RD(read)
Запись/считывание	W/R
Входные данные	DI
Выходные данные	DO
Данные: вход-выход	DIO
Регенерация	REF
Программирование	PR
Стирание	ER
Напряжение питания	Ucc
Напряжение программирования	UPR
Общий вывод	OV

Условное обозначение микросхем памяти

Индекс	Назначение
PM	Матрицы ОЗУ
PB	Матрицы ПЗУ
PU	ОЗУ
PT	Программируемые ПЗУ
PE	ПЗУ масочные
pp	Репрограммируемые ПЗУ с электрическим стиранием
рФ	Репрограммируемые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием
РА	Ассоциативные ОЗУ
РЦ	ЗУ на ЦМД
РП	Прочие

Обозначение функций элементов

Наименование вывода	Обозначение
Постоянное ЗУ (ПЗУ)	ROM
Перепрограммируемое ПЗУ (ППЗУ)	PROM
ПЗУ с многократным программированием (РПЗУ)	RPR0M(EEPROM)
Репрограммируемое ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием (РФПЗУ)	UVPROM(EPROM до 1993 г.)
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)	RAM

Технологии изготовления микросхем

Серия МКС	Технология	Пояснение
176	КМОП, КМДП Совместимы с МКС ТТЛ технологии	Комплементарные полевые транзисторы со структурой металл-окисел-полупроводник. Комплементарный-взаимо-дополняющий (разные проводимости)
537	КМДП	Функциональный ряд серии включает более 20 типономиналов, отличающихся ёмкостью от 1024 до 65536 бит. Организация одноразрядная, словарная. Ucc = 5в
541	ИИЛ-ТТЛ	Биполярные транзисторы статических ОЗУ
556	ТТЛШ	Динамические ОЗУ
565	n-МДП	Электрический конденсатор внутри МДП структуры
573	n-МДП	Входы и выходы имеют уровни ТТЛ, логическая 1 = 2,4 в
1601	МНОП	Логический 0 = 0,4 в. Выходы с тремя состояниями. Быстродействие 55...200Нс
132	n-МДП	В режиме считывания взаимозаменяемы с МКС РПЗУ К573РФ2, К573РФ5
1610	n-МДП	